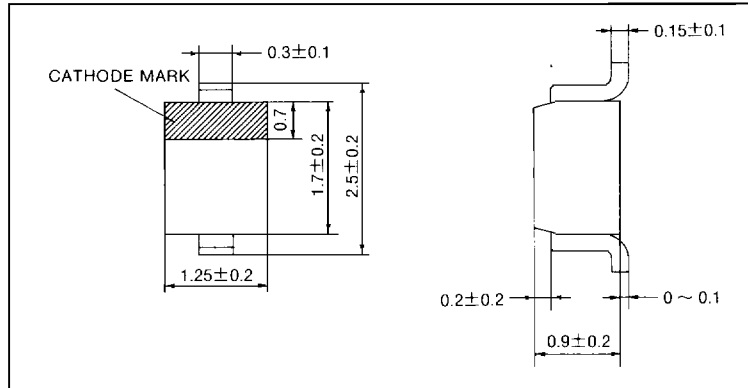


1SV223 (開発中/Under Development)

シリコンエピタキシャルプレーナ形バリキャップダイオード Silicon Epitaxial Planar Variable Capacitance Diode

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 特長

- 1) 超小型である。(ダブルリードスーパーミニモールドタイプ)
- 2) 高信頼度である。

● Features

- 1) Ultrasmall size (doublelead super-mini mold type)
- 2) High reliability

● 用途

同調用

● Applications

For tuning

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
尖頭逆電圧	V_{RM}^*	35	V
直流逆電圧	V_R	30	V
接合部温度	T_j	120	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-30 ~ +120	°C

* $R_L > 10k\Omega$

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	--	--	10	nA	$V_R = 28V$
端子間容量	C_{t1}	14.0	--	16.04	pF	$V_R = 2V, f = 1MHz$
	C_{t2}	2.05	--	2.39	pF	$V_R = 25V, f = 1MHz$
直列抵抗	R_S	--	--	0.6	Ω	$C_1 = 14pF, f = 470MHz$

ダイオード
バリキャップダイオード